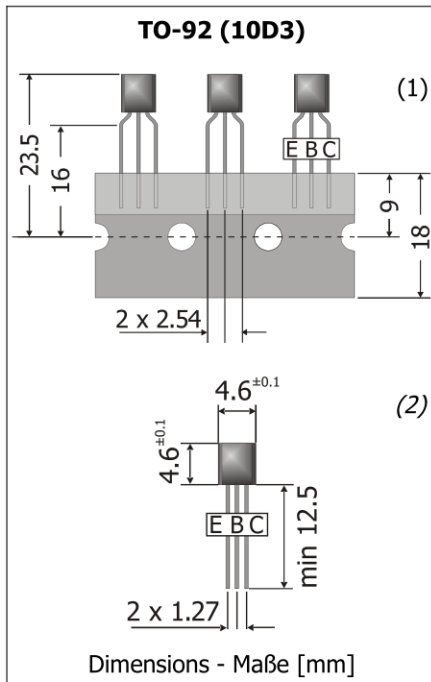


MPSA56 General Purpose PNP Transistors Universal-PNP-Transistoren	I_C = - 500 mA h_{FE} >100 T_{Jmax} = 150°C	V_{CEO} = - 80 V P_{tot} = 625 mW
--	---	--

Version 2018-01-19



Typical Applications

Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade ¹⁾

Features

General purpose
Two raster versions
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾



Mechanical Data ¹⁾

(1) Taped in ammo pack (Raster 2.54)	4000
(2) On request: in bulk (Raster 1.27, suffix "BK")	5000
Weight approx.	0.18 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s
	MSL N/A

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Universell anwendbar
Zwei Raster-Versionen
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

(1) Gegurtet in Ammo-Pack (Raster 2.54)	
(2) Auf Anfrage: Schüttgut (Raster 1.27, Suffix "BK")	
Gewicht ca.	
Gehäusematerial	
Löt- und Einbaubedingungen	

Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren	MPSA06
--	--------

Maximum ratings ²⁾

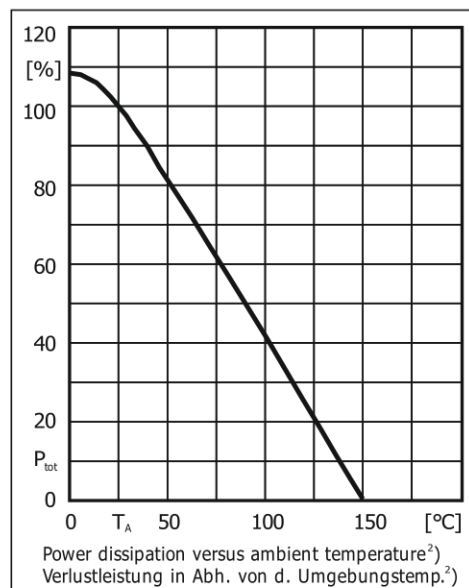
Grenzwerte ²⁾

			MPSA56
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	80 V
Collector-Base-voltage Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	80 V
Emitter-Base-voltage Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	4 V
Power dissipation Verlustleistung		P _{tot}	625 mW ³⁾
Collector current Kollektorstrom	DC	- I _C	500 mA
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		- I _{CM}	1 A
Peak Base current Basis-Spitzenstrom		- I _{BM}	200 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _J T _S	-55...+150°C -55...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C, unless otherwise specified – T_A = 25°C, wenn nicht anders angegeben
3 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics**Kennwerte**

		$T_j = 25^\circ\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾					
- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- $I_C = 10\text{ mA}$ - $I_C = 100\text{ mA}$	h_{FE}	100 100	–	–
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ¹⁾					
- $I_C = 100\text{ mA}$	- $I_B = 10\text{ mA}$	- V_{CEsat}	–	–	0.25 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾					
- $I_C = 100\text{ mA}$	- $V_{CE} = 1\text{ V}$	- V_{BE}	–	–	1.2 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom					
- $V_{CB} = 80\text{ V}$	E open	- I_{CBO}	–	–	100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom					
- $V_{EB} = 4\text{ V}$	C open	- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
- $I_C = 100\text{ mA}$, - $V_{CE} = 1\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$		f_T	50 MHz	–	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	< 200 K/W ²⁾		



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\ \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden